



これからの未来を担う 新ワイドギャップ酸化物材料 Ga_2O_3

Gallium Oxide :

Novel Wide Band-Gap Oxide Material for Future Generation

第78回応用物理学会秋季学術講演会 福岡国際会議場

平成29年9月8日(水) 13:00~17:00

酸化ガリウム(Ga_2O_3)は5.0 eV近いバンドギャップを有する材料です。過去このような広いバンドギャップを有する材料は絶縁体として利用されてきましたが、最近の伝導性の操作などから半導体としての応用が着目されるようになってきました。本シンポジウムでは、 Ga_2O_3 の基板および薄膜について、結晶の性質、成膜特性、作製技術、理論物性、不純物ドーピング、基礎特性から応用特性に関する講演をして頂いただき、聴講者に酸化ガリウムに関する知識をより深めて頂ければという思いから開催に至りました。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

招待講演（敬称略）

島村 清史	物材機構	β - Ga_2O_3 単結晶:込めた思いと今後の期待
千川 圭吾	信州大学	垂直ブリッジ方法による β - Ga_2O_3 結晶成長
大島 祐一	NIMS	準安定相酸化ガリウムのハライト気相成長
大島 孝仁	佐賀大学	(Al,Ga) $_2\text{O}_3$ 混晶系の現状について
三上 拓	富士経済	パワーデバイス市場の現状と酸化ガリウム系パワーデバイスの可能性
藤田 静雄	京都大学	コランダム構造 α - Ga_2O_3 のデバイス化への展望
東脇 正高	NICT	Ga_2O_3 電子デバイス開発の現状と展望 ~パワーデバイス、そして~

【企画】 合同セッションK 【世話人】 川原村敏幸（高知工大） 阿部友紀（鳥取大）